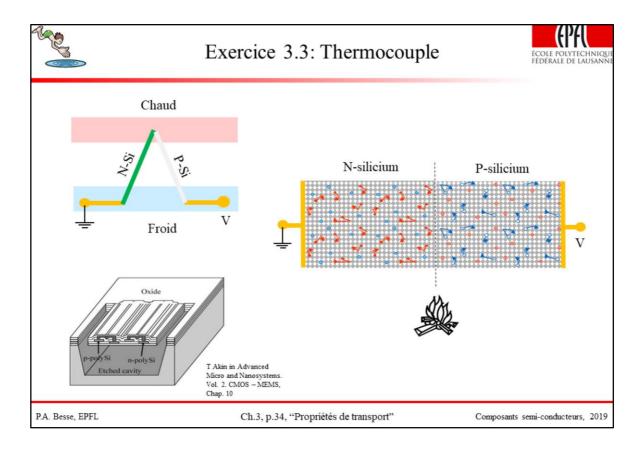


Considérons un silicium dopé N. Nous le contactons en deux points. Une pointe est froide, l'autre est simplement constituée d'un fer à souder, chauffant fortement le point de contact. Quel est le signe de la tension V mesurée sur le contact chaud ?

<u>Modèle par analogie:</u> Les porteurs libres se comportent comme des gens sur une piste de dance. Lorsque d'un côté un groupe « s'échauffe », il prend plus de place.

- a) Esquissez la densité de porteurs libres sur une structure à une dimension.
- b) Déduisez la densité de charges (zone d'accumulation, neutre et de déplétion).
- c) Esquissez le champ électrique.
- d) À partir des charges et du champ électrique esquissez le comportement des bandes.
- e) Déduisez le signe de la tension V.
- f) Que se passe-t-il si le wafer est du P-silicium?

<u>Remarque</u>: Cette expérience est effectuée pour déterminer simplement le type N ou P d'un wafer.



Considérons un thermocouple composé d'un silicium dopé N et d'un silicium dopé P. La jonction est chauffée. Quel est le signe de la tension V mesurée sur le contact P?

<u>Modèle par analogie:</u> Les porteurs libres se comportent comme des gens sur une piste de dance. Lorsque d'un côté un groupe « s'échauffe », il prend plus de place.

Négligez les effets à la jonction NP et ne considérez que chaque région prise séparément (une région N-Si et une région P-Si).

- a) Esquissez, dans chaque région, la densité de porteurs libres due à la différence de température.
- b) Déduisez dans chaque région la densité de charges (zone d'accumulation, neutre et de déplétion) due à ΔT.
- c) Esquissez le champ électrique dans chaque région.
- d) La tension V est reliée au champ électrique E par E=-grad(V). Déduisez le signe de la tension V.

<u>Remarque</u>: Ce thermocouple peut être intégré en technologie CMOS en utilisant par exemple les contacts N-Poly et P-Poly. Les applications sont pour des senseurs de température ou des capteurs infrarouges (caméras de thermographie).